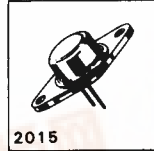


# 2SD315 2SB509

低周波電力増幅用



2015

Mesa Type Silicon Transistor  
For AF Power Amplifier Use

★A complementary pair.

⊖ C444

- ・ 20~30 W の低周波パワーアンプ出力段用に最適。これらはコンプリメンタリペアを組むことができる。
- ( ) 内は 2SB509 の場合を示す。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$

			unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	(-)60	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	(-)60	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$	(-)5	V
コレクタ電流	$I_C$	(-)4	A
ピークコレクタ電流	$i_{cp}$	(-)10	A
コレクタ損失	$P_C$	$T_c=25^\circ\text{C}$	35 W
接合部温度	$T_J$		150 $^\circ\text{C}$
保存周囲温度	$T_{stg}$		-40~+150 $^\circ\text{C}$

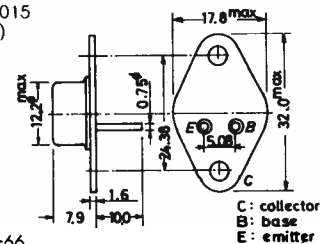
電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$

			min	typ	max	unit
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = (-)20\text{V}, I_B = 0$		(-)0.1		mA
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = (-)4\text{V}, I_C = 0$		(-)1.0		$\mu\text{A}$
二次降伏電圧	$V_{S/B}$	$I_C = (-)0.5\text{A}, t = 1\text{sec}$	(-)60			V
直流電流増幅率	$\times h_{FE}(1)$	$V_{CE} = (-)2\text{V}, I_C = (-)1\text{A}$	$\times 40$		$\times 320$	
	$h_{FE}(2)$	$V_{CE} = (-)2\text{V}, I_C = (-)0.1\text{A}$	40			
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = (-)5\text{V}, I_C = (-)0.5\text{A}$		8		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = (-)2\text{A}, I_B = (-)0.2\text{A}$	(-)0.4	(-)1.0		V
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$I_C = (-)1\text{A}, V_{CE} = (-)2\text{V}$	(-)1.5			V

※ 2SB509, 2SD315 は 2V 1A  $h_{FE}$  により次のように分類している。

40	C	80	60	D	120	100	E	200	160	F	320
----	---	----	----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

外形図 2015  
(unit : mm)



JEDEC TO-66

